

整理番号 = P-4

年 10 月 9 日
頁: 1 / 7

【書類名】

【図 1】

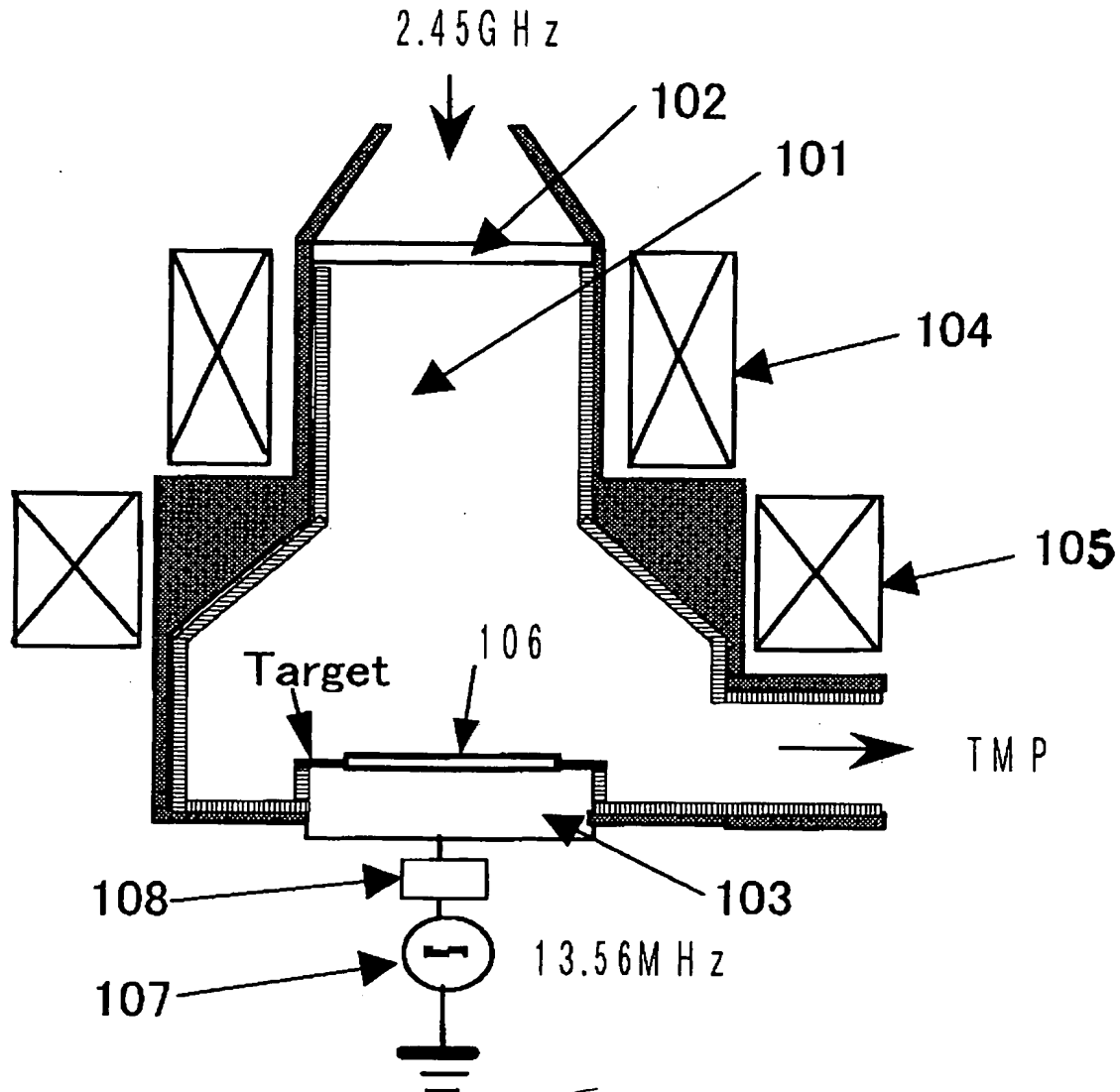


Fig. 1

【図2】

Fig. 2(a)

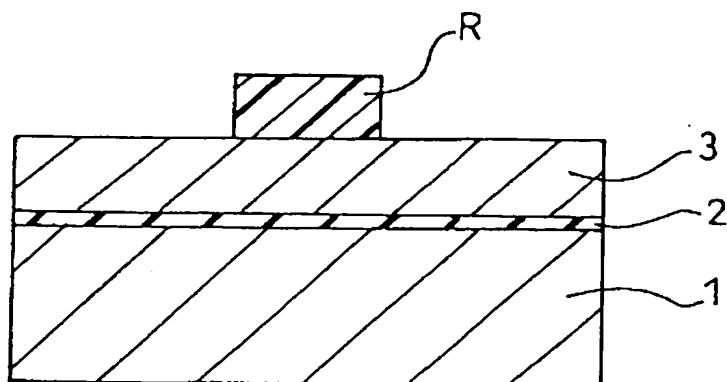


Fig. 2(b)

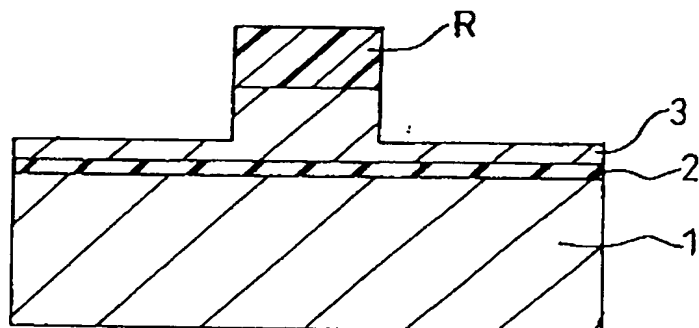
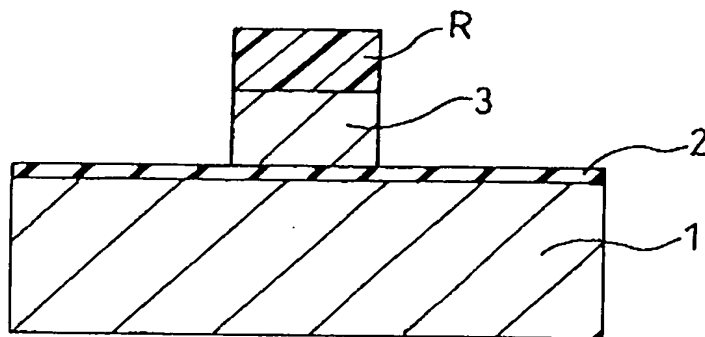


Fig. 2(c)



【図 3】

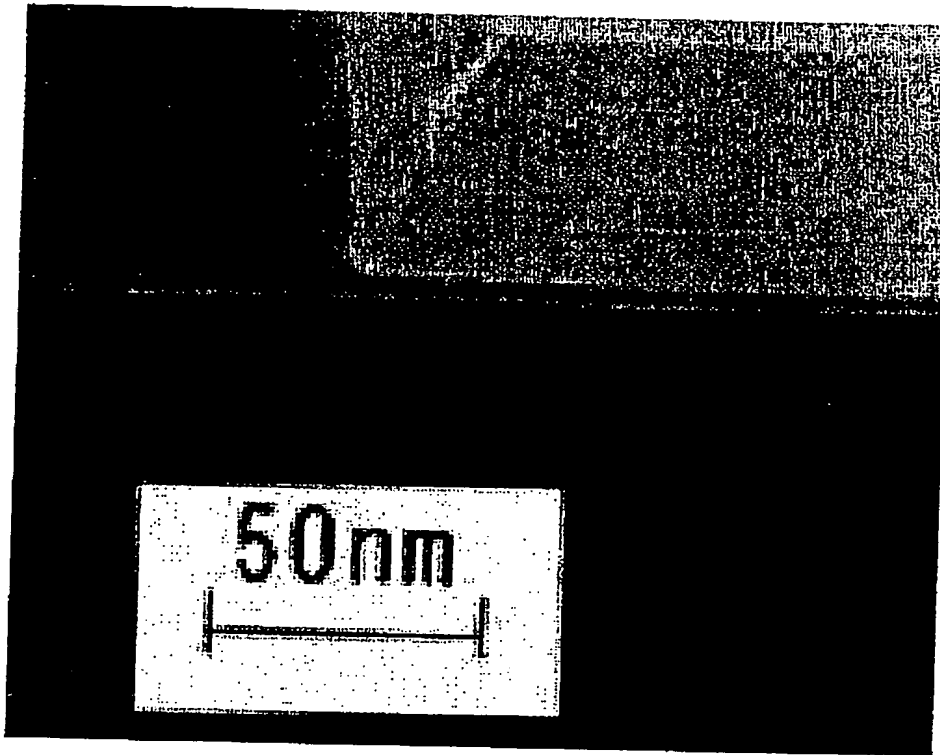


Fig-3

【図 4】

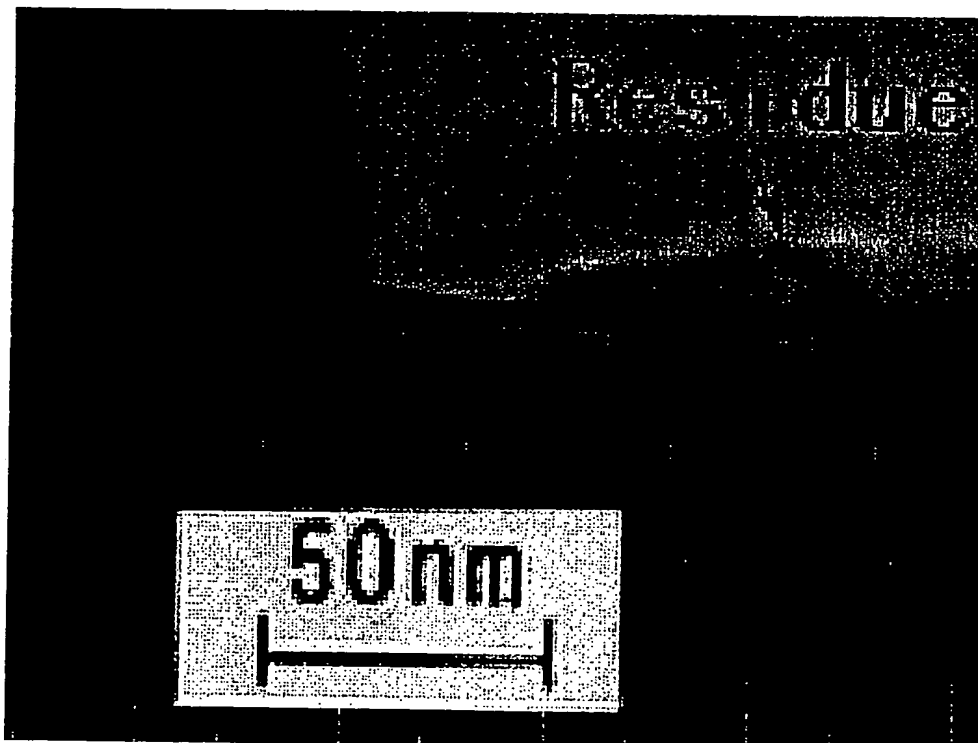


Fig-4

整理番号 = P - 4

年 10 月 9 日
頁: 4 / 7

【図 5】

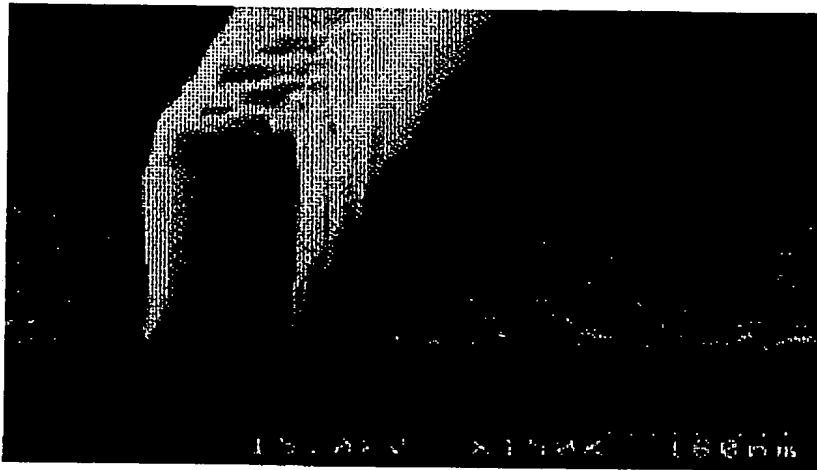


Fig. 5

【図 6】

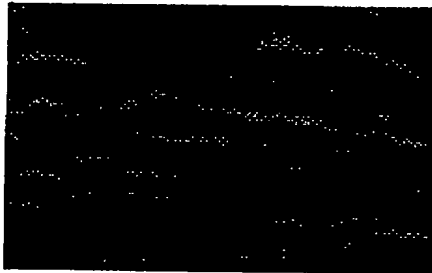


Fig 6 (a) partially etched polySi



Fig 6 (b) gate oxide surface
Surface morphology of polySi and gate oxide.

【図 7】

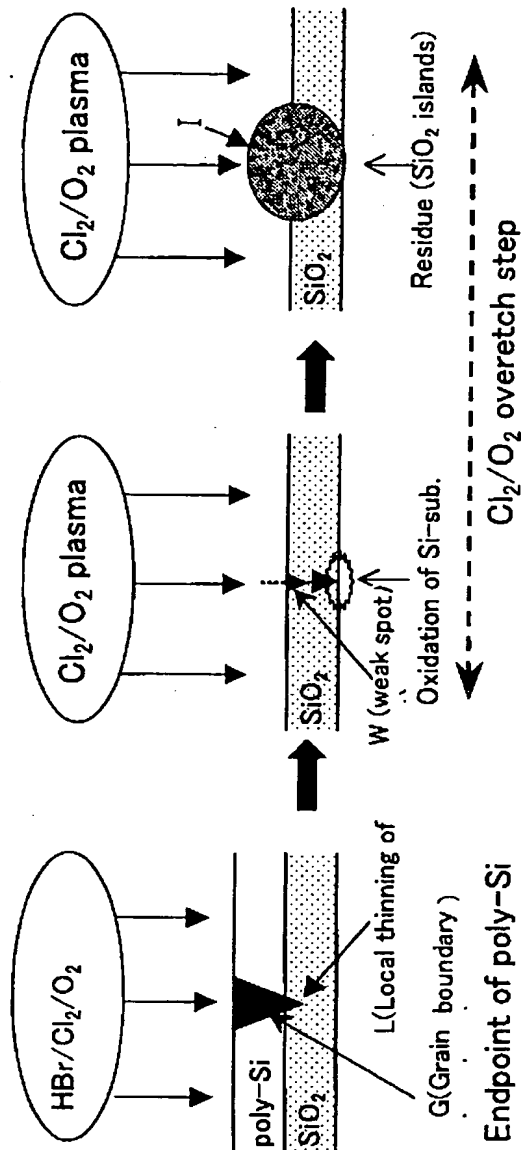
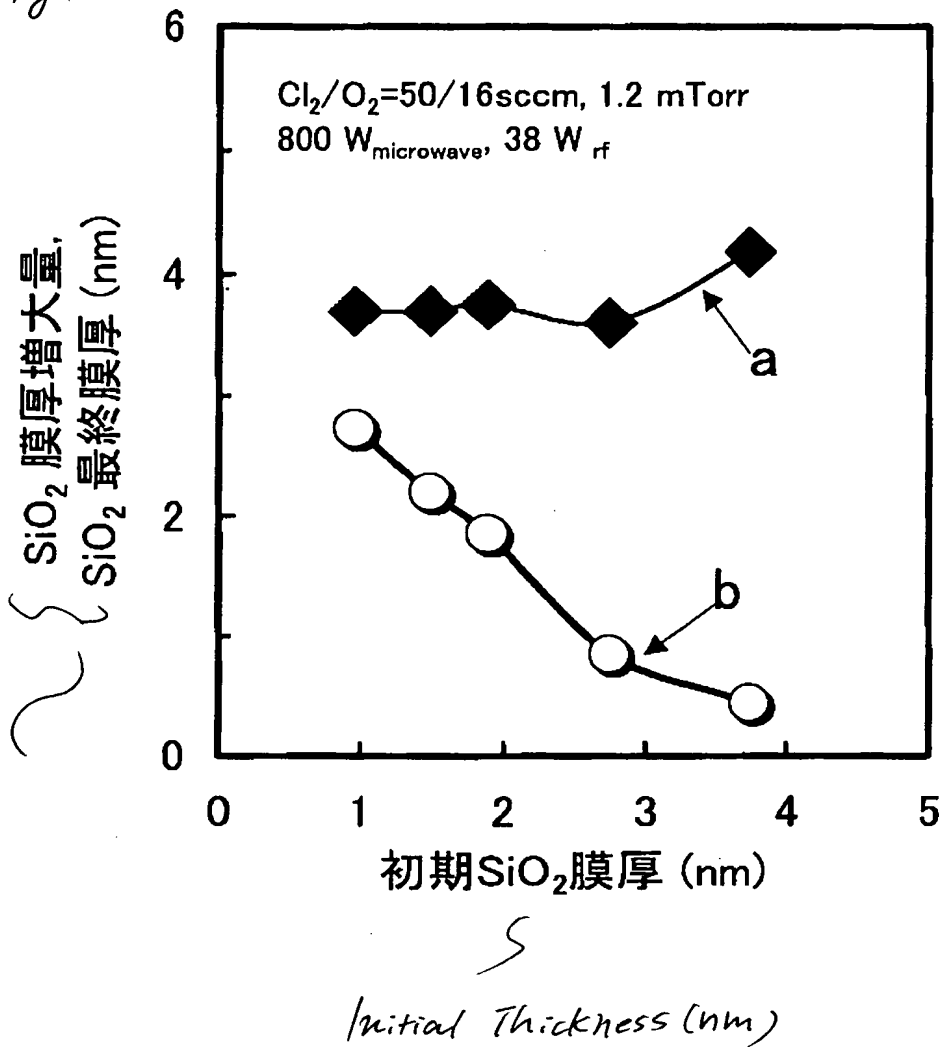


Fig. 7

整理番号 = P - 4

年 10 月 9 日
頁: 6 / 7

【図 8】
Fig. 8

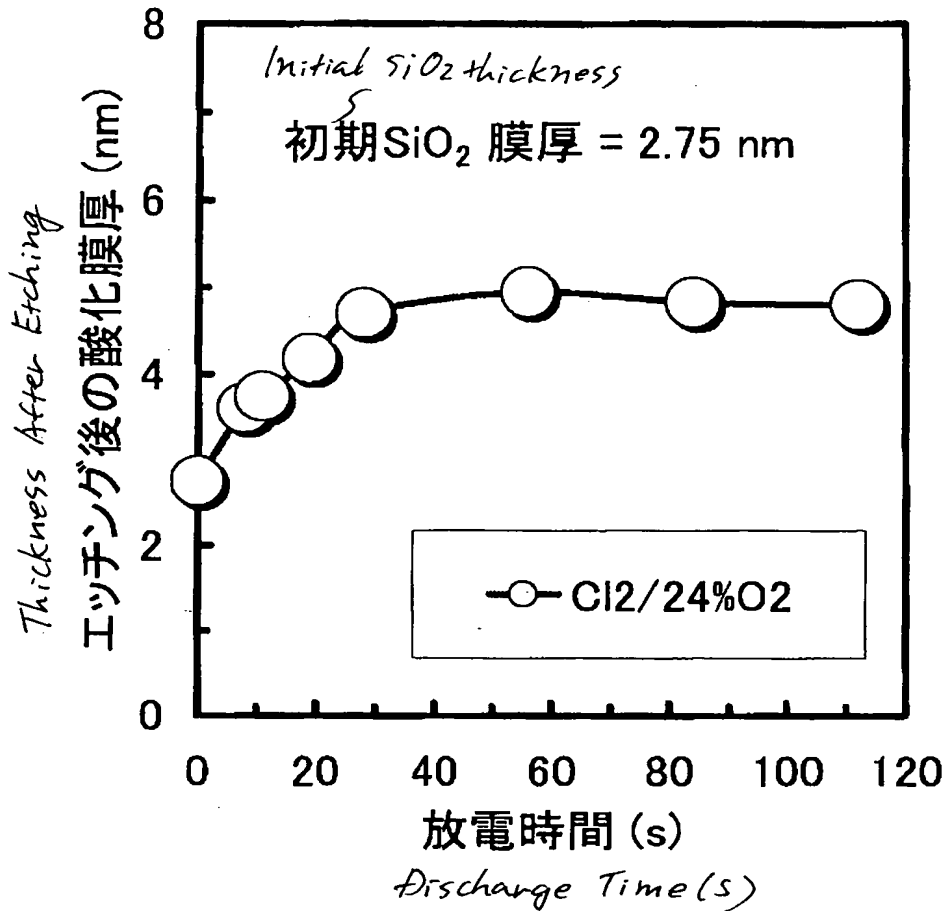


整理番号 = P -

4年10月 9日
頁: 7/ 7

【図9】

Fig. 9



【図10】

Fig. 10

